

IEEE Xplore

Una guía para el usuario

Biblioteca Virtual



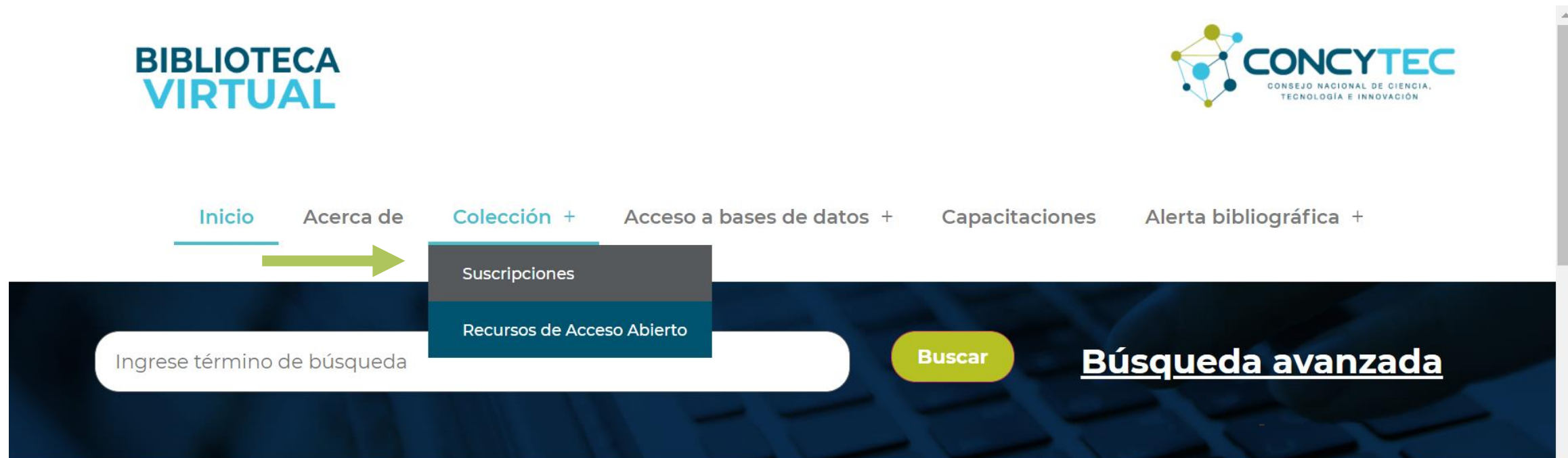
IEEE

Es una base de datos de investigación académica que proporciona acceso a documentos en texto completo referentes a ingeniería eléctrica, electrónica, computación y mecatrónica.

¿Cómo acceder a IEEE Xplore?



1. Ingrese a la Biblioteca Virtual de **Concytec** (<https://biblioteca.concytec.gob.pe/>) y seleccione en el menú principal la opción “**Colección**” y luego “**Suscripciones**”.





2. . Identifique la base de datos IEEE Xplore para acceder y luego pulse **“Ingresar”**. Esta base de datos está dirigida a usuarios Renacyt.



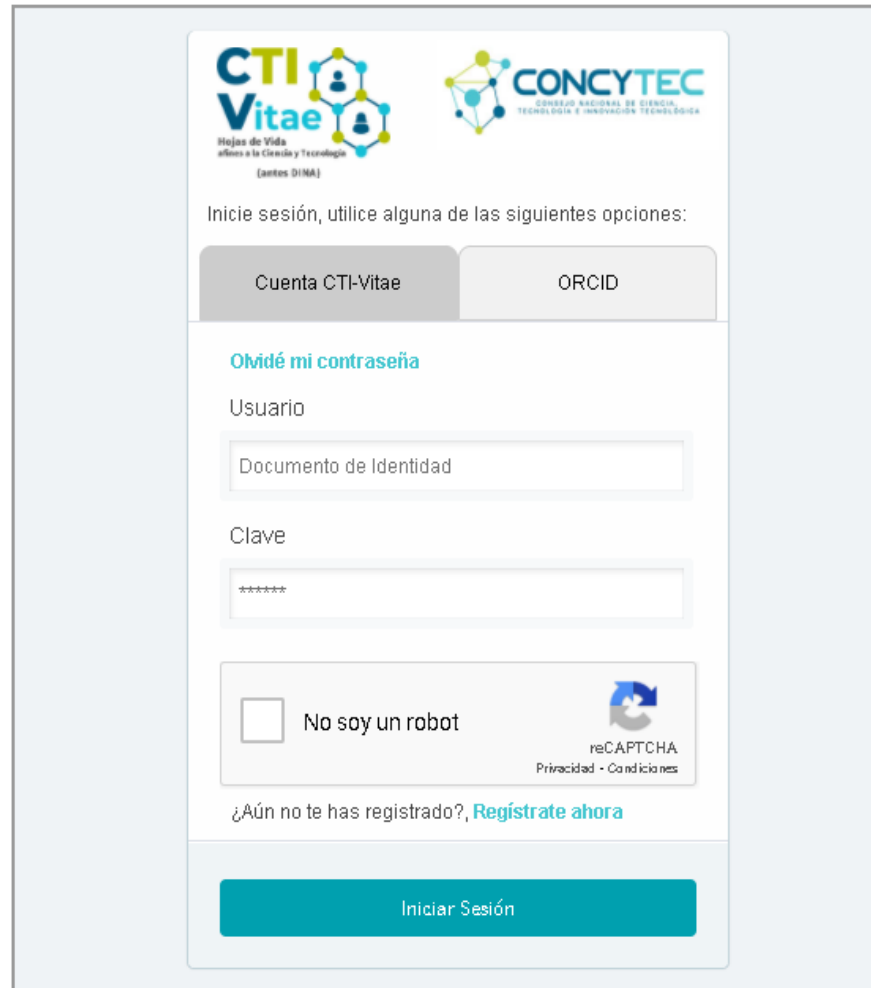
IEEE ofrece acceso en texto completo a más de un millón de documentos provenientes de: 184 IEE Journals, magazines, transactions; 1,500 IEEE conference; 26 IET journals; 20 IET Conference; mas de 30,000 capítulos de libros IEEE-WILEY-MIT en áreas como: aerospace, bioengineering, communication, networking broadcasting, components, circuits, devices; systems, computing processing, engineered materials, dielectrics plasmas, engineering Profession, fields, waves electromagnetics, general Topics for engineers, geoscience, nuclear engineering, photonics electro-optics, power, energy industry applications, robotics control systems, signal processing analysis, transportation.

Acceso directo para usuarios Renacyt: **Ingresar**





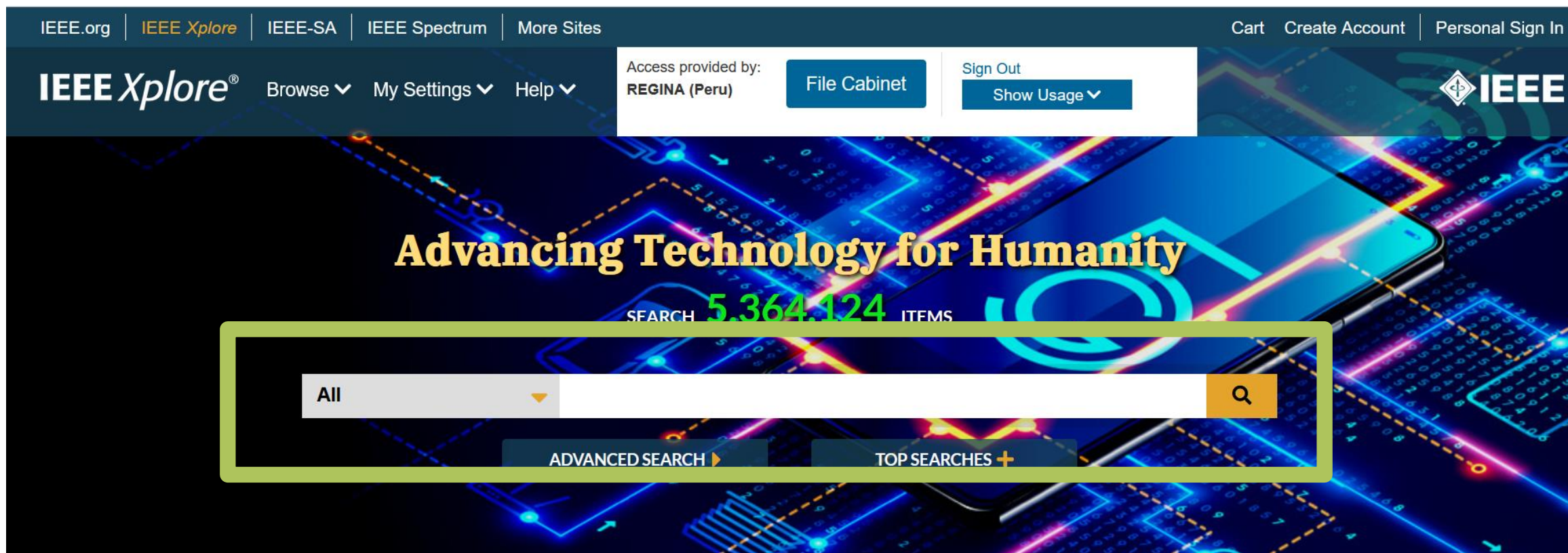
3. El sistema va a solicitar su autenticación, complete los datos con su usuario CTI-Vitae (antes DINA), pulse en el cajón “No soy un robot” e inicie su sesión para acceder a la base de datos y realizar búsquedas.



The screenshot shows the login interface for CTI-Vitae. At the top, there are logos for CTI Vitae (Hojas de Vida afines a la Ciencia y Tecnología, antes DINA) and CONCYTEC (CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA). Below the logos, the text "Inicie sesión, utilice alguna de las siguientes opciones:" is displayed. There are two buttons: "Cuenta CTI-Vitae" (highlighted) and "ORCID". Below these buttons is a link "Olvidé mi contraseña". The login form includes fields for "Usuario" (with "Documento de Identidad" as a placeholder) and "Clave" (with "*****" as a placeholder). Below the password field is a reCAPTCHA section with a checkbox labeled "No soy un robot" and the reCAPTCHA logo. At the bottom of the form, there is a link "¿Aún no te has registrado?, Regístrate ahora" and a large blue button labeled "Iniciar Sesión".

¿Cómo realizar búsquedas en IEEE Xplore?

4. En la página principal de IEEE Xplore coloque la palabra clave en el buscador. Se recomienda utilizar términos en inglés.



The screenshot shows the IEEE Xplore homepage. The top navigation bar includes links to IEEE.org, IEEE Xplore, IEEE-SA, IEEE Spectrum, and More Sites. On the right, there are links for Cart, Create Account, and Personal Sign In. The main header features the IEEE Xplore logo, navigation links (Browse, My Settings, Help), and a white box indicating access provided by REGINA (Peru) with buttons for File Cabinet, Sign Out, and Show Usage. The background is a vibrant blue and orange digital graphic with the text "Advancing Technology for Humanity". Below this, a search bar displays "SEARCH 5.364.124 ITEMS". A green rectangular box highlights the search interface, which includes a dropdown menu set to "All", a search input field with a magnifying glass icon, and two buttons: "ADVANCED SEARCH" and "TOP SEARCHES".



5. Al digitar la palabra clave a buscar, IEEE Xplore le va brindando alternativas de términos, puede seleccionar alguna de ellas o completar la palabra clave que usted haya considerado.



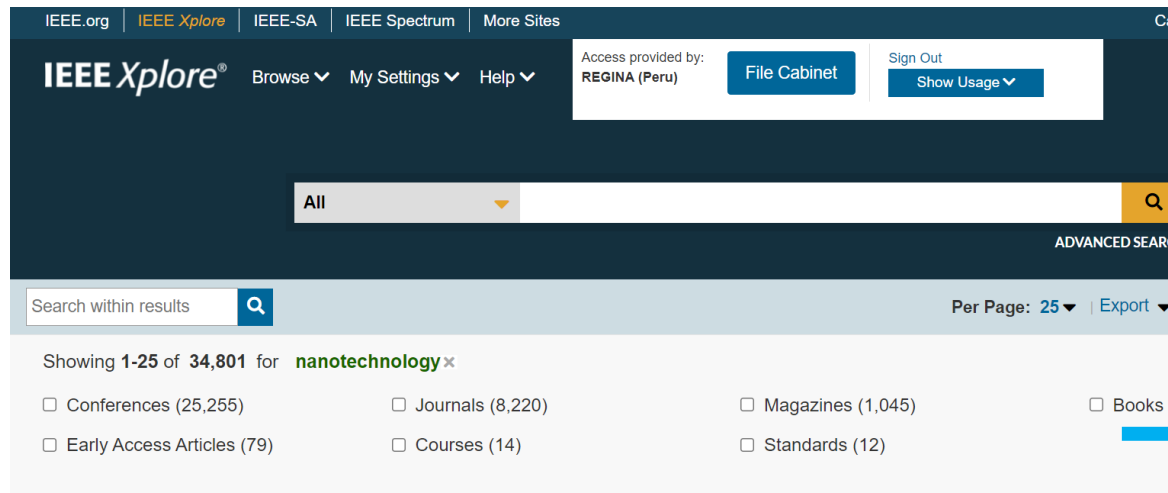
Advancing Technology for Humanity

SEARCH **5.364.124** ITEMS

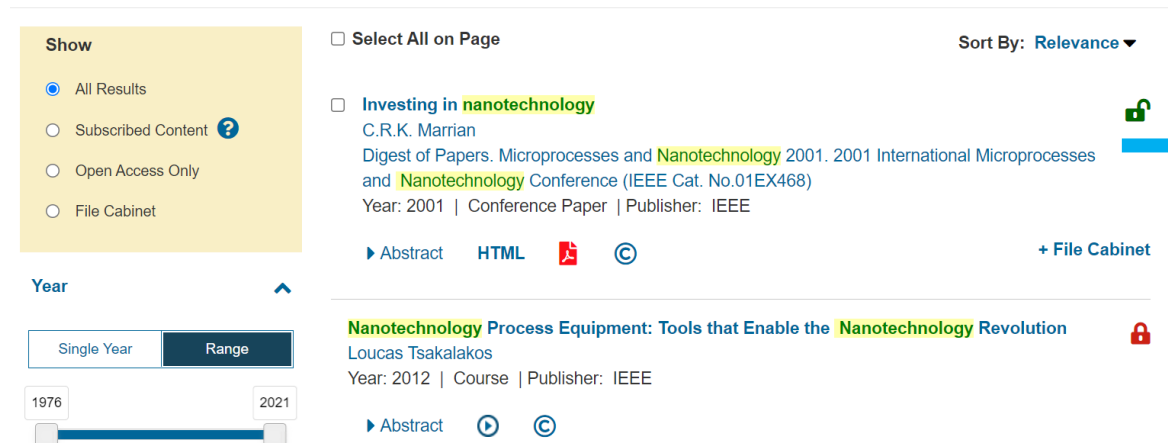
All nanot

- nanotechnology
- nanotube devices
- nanotubes
- Nanotechnology, IEEE Conference on Nanotechnology Materials and Devices Conference (NMDC), IEEE
- Nanotechnology in Instrumentation and Measurement (NANOFIM)
- Nanotechnology for Instrumentation and Measurement (NANOfIM)
- Nanotechnology Symposium (ANS), 2019 IEEE Albany
- Nanotechnology Symposium (ANTS), IEEE

6. Al ingresar el término de búsqueda, la base de datos mostrará un listado con los resultados encontrados. Puede seleccionar por tipo de documento.



- Seleccione el tipo de documento: Revistas académicas (Journals), conferencias, etc.



- Los documentos disponibles para descarga se mostrarán con un símbolo de candado en color verde.



7. Para limitar los resultados en la búsqueda, puede utilizar los filtros de la columna izquierda: Por tipo de acceso, año de publicación, etc.

Show

☒ All Results

☐ Subscribed Content 

☐ Open Access Only

☐ File Cabinet

Year



Single Year **Range**

1992 2021



Author



Affiliation



Publication Title



Publisher



Supplemental Items



Publication Topics



8. Para revisar el contenido del documento, haga clic sobre el título y visualizará los detalles de la publicación, el vínculo para acceder al texto completo y una lista de artículos relacionados.

[Journals & Magazines](#) > [IEEE Journal of the Electron ...](#) > [Volume: 2 Issue: 6](#) [?](#)

[Back to Results](#) | [Next >](#)

Integration of Micro Resistance Thermometer Detectors in AlGaIn/GaN Devices

Publisher: IEEE [Cite This](#) [PDF](#)

[Osvaldo Arenas](#) [id](#) ; [Élias Al Alam](#) ; [Alexandre Thevenot](#) ; [Yvon Cordier](#) ; [Abdelatif Jaouad](#) ; [Vincent Aimez](#) ; [Hassan Maher](#) ; [Ric...](#) [All Authors](#)

8
Paper
Citations

908
Full
Text Views

[R](#) [Share](#) [C](#) [Folder](#) [Bell](#)

[Open Access](#)

Abstract

Document Sections

[I. Introduction](#)

[II. Design for Electro-Thermal Characterization](#)

[III. Device Fabrication](#)

[IV. Experimental Measurements](#)

[V. Validation and Analysis](#)

[Show Full Outline](#)

[Authors](#)

Abstract:

Temperature measurements in AlGaIn/GaN high electron mobility transistors are required for proper device design, modeling and achieving appropriate reliability. These measurements usually require sophisticated equipment and extensive calibration. This study evaluates the feasibility of temperature measurements by integration of a Pt resistance thermal detector (RTD) in an "un-gated" transistor and evaluating their electrical interactions. The integrated RTD presents the advantage of being independent of the device. Micro RTD showed a linear response in the calibration interval (0 to 206 °C). Measured temperature values using the micro RTD are in agreement with 3D finite element simulations at multiple bias conditions in the "un-gated" transistor. Measurements show no noticeable electrical perturbation between the device and RTD under simultaneous operation.

Published in: [IEEE Journal of the Electron Devices Society](#) (Volume: 2 , Issue: 6, Nov. 2014)

Page(s): 145 - 148 **INSPEC Accession Number:** 14695964

Date of Publication: 08 August 2014 [?](#) **DOI:** [10.1109/JEDS.2014.2346391](#)

Electronic ISSN: 2168-6734 **Publisher:** IEEE

More Like This

[Nanometer-Scale Strain Measurements in AlGaIn/GaN High-Electron Mobility Transistors During Pulsed Operation](#)
IEEE Transactions on Electron Devices
Published: 2016

[Electrothermal Evaluation of AlGaIn/GaN Membrane High Electron Mobility Transistors by Transient Thermoreflectance](#)
IEEE Journal of the Electron Devices Society
Published: 2018

[Show More](#)

IEEE Authors:

Increase Your Research Impact

Add executable code to your research articles



9. Para descargar el documento a texto completo, pulse en el botón que contiene el logo de PDF.

Journals & Magazines > IEEE Journal of the Electron ... > Volume: 2 Issue: 6 ?

Integration of Micro Resistance Thermometer Detectors in AlGaIn/GaN Devices

Publisher: IEEE

Cite This

 PDF

Osvaldo Arenas  ; Élias Al Alam ; Alexandre Thevenot ; Yvon Cordier ; Abdelatif Jaouad ; Vincent Aimez ; Hassan Maher ; ...

[All Authors](#)

8
Paper
Citations

908
Full
Text Views



Open Access

IEEE Xplore

Una guía para el usuario